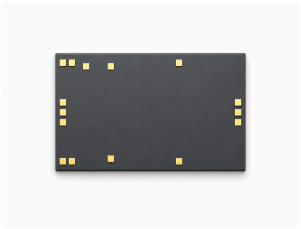
Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 6700–7400 MHz

LCI-PA-6700-7400-PS41T es un amplificador de potencia GaN MMIC en formato de die sin encapsular para 6700–7400 MHz. Admite funcionamiento pulsado.



Valores de la tabla RF: Potencia de salida saturada: 41 dBm (típico); Ganancia de potencia: 22 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 55 % (típico). Condiciones de ensayo RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. Dimensiones del die: 3.2 × 2 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	6700	-	7400	MHz
Potencia de salida saturada	Psat	-	41	-	dBm
Ganancia de potencia	Gp	-	22	-	dB
Planitud de la ganancia de potencia	ΔGp	-	-	±0.5	dB
Eficiencia de potencia añadida	PAE	-	55	-	%
Ganancia de pequeña señal	S21	-	34	-	dB
Planitud de la ganancia de pequeña señal	ΔS21	-	-	±0.5	dB
VSWR de entrada	VSWR(in)	-	1.6	1.8	-

Polarización DC y corrientes

TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión de drenador	Vd	-	28	32	V
Tensión de puerta	Vg	-3.1	-2.8	-2.6	V
Corriente de drenador en reposo	Id	-	0.38	-	A
Corriente dinámica de drenador	Idd	-	0.8	-	A
Corriente dinámica de puerta	Igg	-	0.1	0.3	mA

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	Vd	-	-	32	V
Polarización de puerta mínima	Vg	-5	-	-	V
Potencia de entrada máxima	Pin	-	-	24	dBm

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Temperatura máxima del canal	Top	-	-	225	°C
Temperatura de almacenamiento	TSTG	-65	-	150	°C

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del die	3.2 × 2 × 0.1	mm
Tolerancia del contorno en planta	±100 (Solo contorno en planta; no se especifica la tolerancia del espesor.)	µm

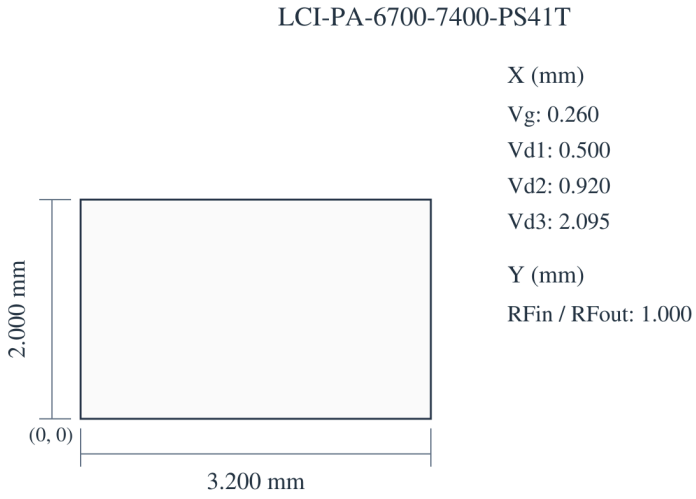
Registro de la publicación actual · 1.8 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.7.

Integración del chip y secuencia de polarización

Al encender, aplicar la polarización de puerta antes que la de drenador. Al apagar, retirar primero la del drenador. Manipular en un entorno limpio con protección ESD y utilizar un soporte con expansión térmica compatible con el die de SiC.

Plano dimensional mecánico

Contorno y coordenadas acotadas en mm. Este plano sirve como referencia dimensional. Para la fabricación y el conexionado por hilo se requieren planos completos.



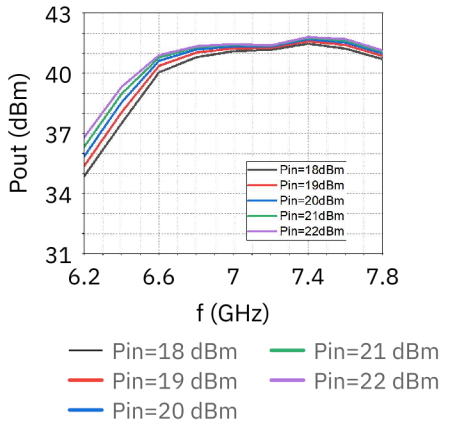
3.200 × 2.000 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

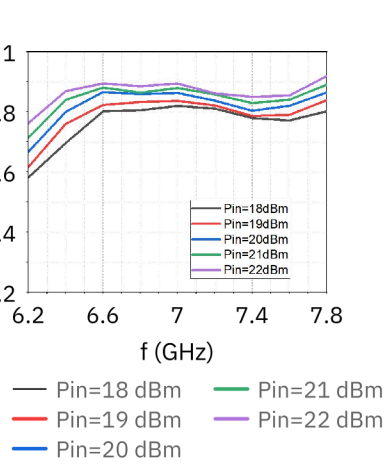
Curvas de rendimiento

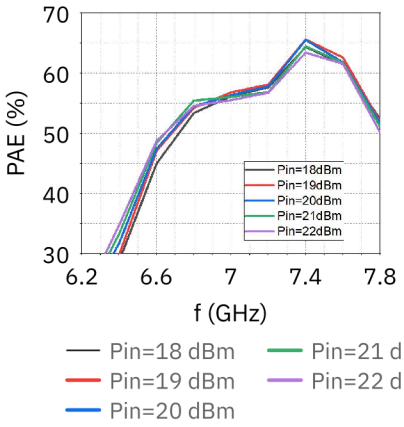
Cada gráfica de rendimiento corresponde a las condiciones de funcionamiento que indica.

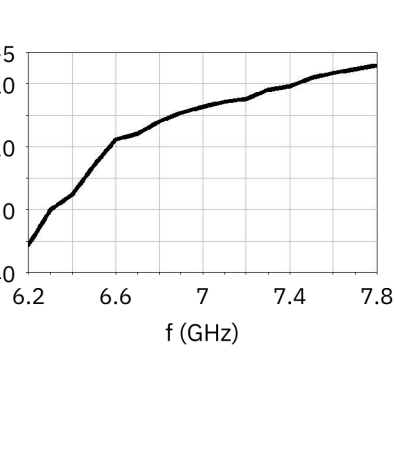
Pulsado — Potencia de salida saturada; Eficiencia de potencia añadida; Corriente dinámica de drenador; Adaptación de entrada; Ganancia.

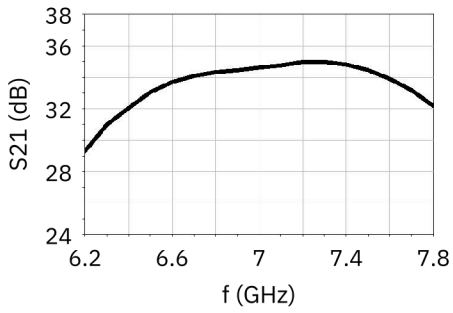
Notas de la figura: TA = +25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V. τ = 100 µs; D = 10%; Pout / PAE / Id: Pin = 18 / 20 / 22 dBm; S11 / S21: Pin = −10 dBm. Las condiciones corresponden a las subfiguras indicadas y a sus propias leyendas.











Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.